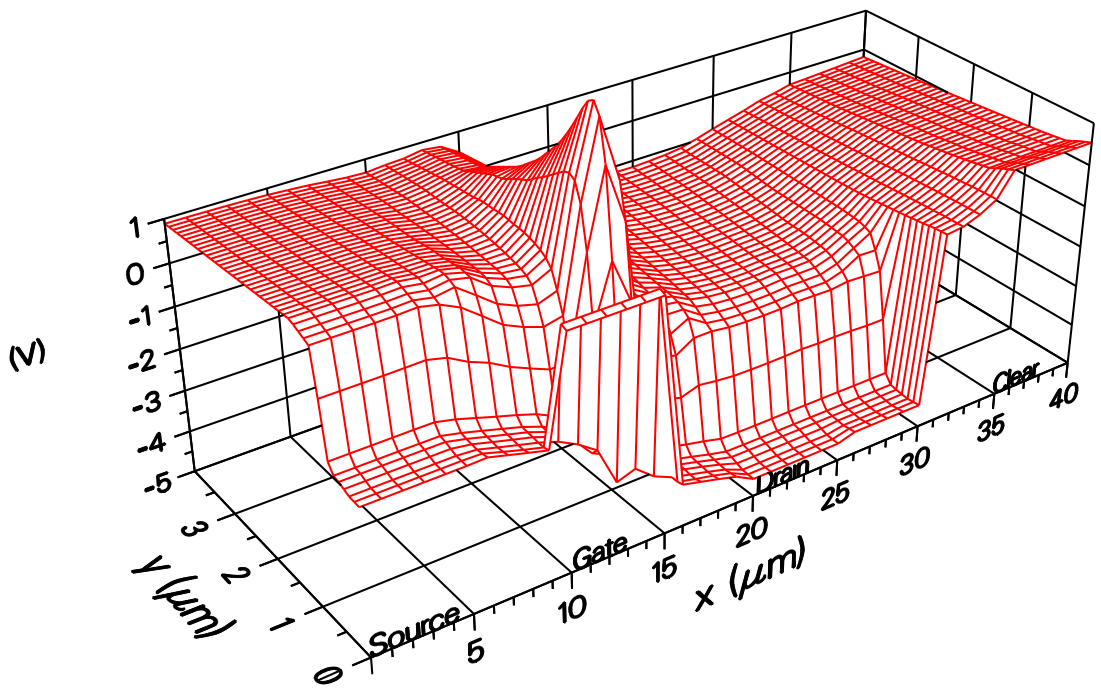
Liite 6. Esimerkki Dissplalla tehdystä kuvasta



Simuloitu potentiaalijakauma JFET-transistorirakenteeseen perustuvassa säteilynilmaisimessa. Säteilyn ionisoimat elektronit kerääntyvät hilan (gate) alla sijaitsevaan potentiaalimaksimiin ja ohjaavat transistorin virtaa.

Tikkanen, Tuomo. Simulation, Design and Testing of a New Silicon Radiation Detector Structure. diplomityö. Teknillinen korkeakoulu. Tietotekniikan osasto, Teknillisen fysiikan laitos, 1991